



面向**SiC MOSFET**的具有段式驱动的先进 高压隔离栅极驱动器

GD3160

Last Updated: Mar 31, 2025

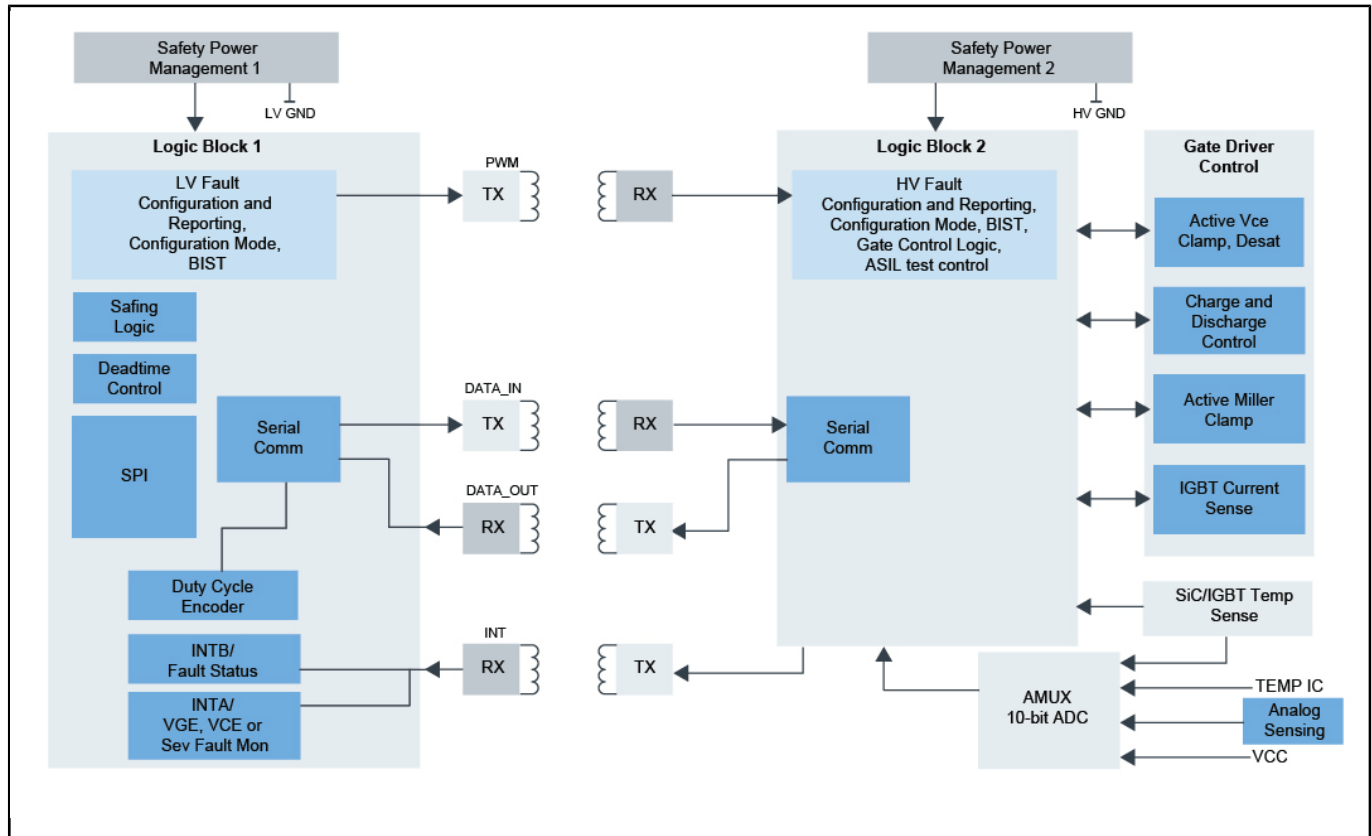
GD3160芯片和支持(文档、软件和板)仅供授权客户使用(需要保密协议(NDA))。如需了解更多信息和样品供货情况, 请联系支持人员或当地销售代表。

GD3160是一种改进的、先进的单通道高压隔离栅驱动器, 具有驱动和保护碳化硅(SiC)MOSFET以及功能安全的增强功能。

借助GD3160的SPI可编程驱动、保护和故障报告功能, 用户可以优化驱动并保护几乎任何SiC MOSFET或Si IGBT电源开关的条件。

GD3160符合ISO26262和汽车标准, 集成了功能安全功能, 减少了物料成本(BOM), 可支持实施符合ASIL D要求和功率密度高效的xEV逆变器解决方案。

面向SiC MOSFET的具有段式驱动的先进高压隔离GD Block Diagram



View additional information for [面向SiC MOSFET的具有段式驱动的先进高压隔离栅极驱动器](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.